连续运转 Ar+ 激光器的最佳气压分析

凌一鸣

(南京工学院电子工程系)

提 要

本文从 Tonks-Langmuir 低气压放电正柱理论出发,推导氩离子激光器输出功率和充气压力的关系,由此求得最佳气压,讨论了最佳气压的影响因素,并与实验结果相比较。

Analysis of optimum gas pressure in CW argon ion lasers

Ling Yiming

(Department of Electronic Engineering, Nanking Institute of Technology)

Abstract

As Tonks-Langmuir lower pressure discharge plasma theory is compared with the operating condition of typical Ar^+ lasers, it is considered that this theory may be adaptive for the analysis of plasma parameters in Ar^+ lasers. It is believed that the two-step process plays an essential role in the excitation mechanism of OW Ar^+ lasers. Consequently, the dependence of the upper laser level population, which is in approximate proportion to laser output, on the filling-gas pressure in CW Ar^+ lasers is derived. The optimum pressure and electric temperature can then be determined. This result is in agreement with the experiment by H. Beorsch *et al.* The deviation between theoretical and experimental results in increasing pressure is explained. Some influential factors for determination of the optimum pressure are also discussed.

一、引 言

氩离子激光器自 1964 年问世以来^[11],对 其特性参量已进行了大量的理论分析和实验 研究。无论如何,氩离子激光器的充气压力 对其性能影响颇大。一般认为,对于激光输 出功率,管内充气压力将具有一最佳值,并象 氦-氛激光管那样习惯用 PR=常数来表示 管内最佳气压。不同作者的实验所报导的 PR值有较大差异。

收稿日期: 1979年6月29日

• 28 •

近来,也有不少作者分析并讨论了氩离 子激光器的最佳电子平均能量,认为它是和 放电电流密度无关的一个参量,J.Eichler 和 H.J.Eichler 认为最佳电子平均能量 $\left(\frac{3}{2} kT_e\right)$ 为(6.5±1)电子伏⁽²⁾。

本文直接从 Tonks-Langmuir 低气压放 电正柱理论,推导了氩离子激光器激光输出 功率和充气压力的关系,由此确定最佳气压 和最佳电子温度,讨论了影响最佳气压的因 素,并与实验结果相比较。

二、理论分析

1. L. Tonks 和 I. Langmuir 低气压放 电等离子区理论的前提和氩离子激光器典型 工作条件

L. Tonks 和 I. Langmuir 于 1929 年首 先奠定了低气压放电等离子区理论的基 础^[33]。该理论的前提是假设气压很低(λ≪*R*) 和电流密度不太大的情况下,认为离子由产 生的地方到达管壁的路程中实际上不发生碰 撞,如同"自由落体"那样落到管壁,而电子由 于管壁附近排斥场的作用,只有最快的电子 才能到达管壁,在那里与离子复合,而其余大 部分电子被该层反射回来。每个落到管壁上 的电子都要经受该层的多次反射,这样大大 增加了与气体分子、离子的碰撞几率。因此, 认为电子能量分布还是服从麦克斯韦分布 的,在这样的前提下推导了一系列放电等离 子区内外参量相互关系的解析式。

众所周知, 氩离子激光器也是以低气压 放电工作的, 其电子平均自由程 λ_e 一般和放 电管径可比拟, 其电流密度达几十至几百安/ 厘米²。 但据 K. G. Hernqvist 的 实验^[4] 和 V. F. Kitaeva 用探板量测电子 温度 T_{ex} 电 子浓度 N_e 等参量表明^[5], 用Tonks-Langmuir 理论计算的结果和实验相差不大。 显然, 这 是由于上述假设低气压放电模型与氩离子激 光器的实验情况还是比较接近的。因此这里 认为用它来分析氩离子激光器放电参量还是 可取的。

2. 激光功率

激光器输出功率的大小将直接取决于激 光工作介质中粒子数反转的大小。对于连续 运转的氩离子激光器而言,激光上能级的粒 子数主要由两步激发过程引起的(如图1所 示^[61]),即认为激光上能级的粒子数主要由离 子基态被电子激发而引起的。



图1 连续工作 Ar+ 激光器激发机理

若设集居在激光上能级的粒子数全部用 于受激发射,则单位体积放电区内所提供的 最大激光功率可表示为^[2]:

$$\phi = h \nu z_{i2} \left\{ 1 - \frac{g_2}{g_1} \left(\frac{A_{21}}{A_1} + \frac{A_2}{A_1} \frac{z_{i1}}{z_{i2}} \right) \right\} \quad (1)$$

式中 z_{i1}、z_{i2} 分别为单位时间单位体积放电区 内离子从基态 s₄ 激发到激光下能级 s₁ 和上 能级 s₂ 的粒子数; g₁、g₂ 为激光下能级和上 能级的统计权重; A₁、A₂ 为激光下能级、上能 级的爱因斯坦系数, A₂₁ 为从能级 2 跃迁到 能级 1 的爱因斯坦系数。对于氩激光 0.448 微米跃迁而言

 $egin{aligned} &A_{21}\!=\!0.0845\! imes\!10^9/ (
onumber) \ &A_{2}\!=\!0.1099\! imes\!10^9/
onumber) \ &A_{1}\!=\!2.84\! imes\!10^9/
onumber) \ &g_{2}/g_{1}\!=\!1.5 \end{aligned}$

而 zn、zi2 相差不大。因此,在氩离子激光器 典型工作条件下,输出功率主要取决于上能

· 29 ·

级粒子数产生率,并与其成正比关系。为获 得最大激光输出,必须力求最大的上能级粒 子数产生率 z₁₂。

3. 激光上能级粒子数产生速率

按照上述两步激发过程,在放电等离子 区内,每个能量为 ε (速度为 v_e)的电子使基 态离子激发到激光上能级的速率为:

$$n_i v_e Q_{i2}(\varepsilon) = n_i \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m_e}} Q_{i2}(\varepsilon)$$
 (2)

式中 n₄ 为离子密度; Q₄₂ 为基态离子激发到 上能级 2 的激发截面,它是电子能量的函数, 因此,每立方厘米内的上能级粒子数激发速 率为:

$$n_e n_i \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m_e}} Q_{i2}(\varepsilon)$$
 (3)

如上所述,认为在 Ar⁺ 激光器的典型工 作条件下,放电等离子区中电子能量分布基 本上符合麦克斯韦分布,即:

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = 2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}} (kT_e)^{-3/2} \exp\left(\frac{-\varepsilon}{kT_e}\right) d\varepsilon$$
(4)

其中只有能量大于(ε₂-ε_i)的电子才有可能 使基态离子激发到上能级。但是,能量大于 管壁电位的电子又很容易打上管壁,对上述 激发过程贡献不大。因此,实际上可以认为 激光上能级粒子数主要由放电等离子体中能 量为

$$\varepsilon_2 - \varepsilon_i < \varepsilon < eV_w$$
 (5)

的电子所产生,其中 V_w为管壁对等离子体的负电位,约为 25 伏左右⁽⁴⁾,也就是说,激 光上能级粒子数主要由能量分布中能量约为 20~25 电子伏的电子与基态离子碰撞所引 起的。对于这样的能量范围,激发截面 Q₁₂ 总 可近似地表示为:

 $Q_{i_2}(\varepsilon) \approx \beta [\varepsilon - (\varepsilon_2 - \varepsilon_i)]$ (6) 并设放电等离子区中 $n_e \approx n_i$,因此,由式(3)、 (4)、(6)得单位时间单位体积内激光上能级 粒子数激发速率为:

$$z_{i2} = n_e n_i \int_{\epsilon_2 - \epsilon_i}^{eV_w} \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m_e}} Q_{i2}(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$= \sqrt{\frac{8}{\pi m_e}} \beta n_e^2 \sqrt{kT_e} \int_{\epsilon_1 - \epsilon_i}^{eV_w} \frac{\varepsilon}{kT_e}$$

$$\cdot \left[\frac{\varepsilon}{kT_e} - \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_i)}{kT_e}\right] \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT_e}\right) d\varepsilon$$

$$= \sqrt{\frac{8}{\pi m_e}} \beta n_e^2 \sqrt{kT_e} \left\{ \left[(\varepsilon_2 - \varepsilon_i) + 2kT_e\right]$$

$$\cdot \exp\left[-\frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_i}{kT_e}\right]$$

$$- (eV_w + 2kT_e) \exp\left[-\frac{eV_w}{kT_e}\right] \right\}$$
(7)

在氩离子激光器中平均电子浓度可表示 为^[7].

 $n_e = 1 \times 10^{15} JPR \left(\frac{300}{T_g} \right)^{1/2}$ (厘米⁻³) (8) 式中 J 为放电电流密度 (安/厘米²), P 为气 体压力 (毫米汞柱), R 为放电半径 (厘米), T_a 为气体温度 (K)。

管壁电位 V_w 、气压P与电子温度 T_s 的 关系可按 Tonks-Langmuir 低气压放电等离 子区理论计算^[3,4]:

$$V_{w} = \frac{kT_{e}}{e} \ln\left(1.045\sqrt{\frac{m_{i}}{m_{e}}}\right) \qquad (9)$$
$$\left(1 + 2\frac{kT_{e}}{\varepsilon_{i}}\right)^{-1} \exp\left(\frac{\varepsilon_{i}}{kT_{e}}\right)$$
$$= 62.8 aV_{i}\sqrt{M} \frac{300}{T_{g}} PR \qquad (10)$$

式中 m_i 为离子质量, m_e 为电子质量, M 为 分子量, V_i 为电离电位, a 为微分电离系数。 将(8)、(9)、(10)式代入(7)式,并令

 $V = \frac{kT_e}{e},$

则

$$z_{i2} = A \frac{T_g}{300} J^2 \frac{\sqrt{V}}{(V_i + 2V)^2} \exp\left(\frac{2V_i}{V}\right) \\ \cdot \left\{ [(V_2 - V_i) + 2V] \exp\left[-\frac{V_2 - V_i}{V}\right] \right. \\ \left. - \frac{2 + \ln 1.045 \sqrt{\frac{m_i}{m_e}}}{1.045 \sqrt{\frac{m_i}{m_e}}} V \right\} \\ = A \frac{T_g}{300} J^2 F(V)$$
(11)

· 30 ·

$$A = \frac{10^{30}}{62.8^2 a^2 M} \sqrt{\frac{8e^3}{\pi m_{\theta}}} \beta$$

对于氩离子激光 0.448 微米的激光跃迁 而言, $V_2=35.3$ 电子伏; $V_i=15.76$ 电子伏; $M=40; m_i/m_o=40 \times 1840; a=0.71, 并取$ $T_g=1200K, 代入(10)、(11) 式得$

$$\begin{pmatrix} 1 + \frac{V}{7.88} \end{pmatrix}^{-1} \exp\left(\frac{1576}{V}\right)$$

= 70.5*PR* (毫米汞柱・厘米) (12)
$$F(V) = \frac{\sqrt{V}}{(15.76 + 2V)^2} \exp\left(\frac{31.32}{V}\right)$$

= $\int (19.54 + 2V) e^{\frac{-19.54}{V}} = 0.0268V$ (13)

由(12)、(13)式可作出 F(PR)的函数曲 线,如图 2 所示,输出功率和气压的关系也将 是同样的曲线。由此可见,曲线具有一最大 值,相应的 PR值约为0.025毫米汞柱•厘米。 由(12)式算得相应的电子温度约为50000K。



三、实验结果及其讨论

据 H. Boersch 等人的实验结果^[8], 激光 输出功率和气压的关系如图 3 所示, 其最佳 气压的经验公式为

PR=2.5×10⁻² (毫米汞柱・厘米) (14) 为便于比较,将上述 F(PR)曲线同时绘于图 3(虚线)。由此可见,两者不仅最佳气压十分 吻合,而且大部分曲线形状也很接近,只是在 较高气压时,两者相差较大,这是由于随着气



压的增加, 上述分析中大于管壁电位的电子 在到达管壁前已经过多次碰撞, 它们所引起 的电离、激发已不可忽略, 因此, 实验值将大 于理论值。

这里利用小功率玻壳结构氩离子激光器 进行试验,其放电管采用膜孔组放电管结构, 膜孔直径为2毫米,膜孔间隔为4毫米,用磁 场对放电箍缩,测得输出功率和气压的关系 如图4所示。可见,曲线和图3几乎具有相 同的形状,只是相当于最佳输出的*PR*值只 有0.01毫米汞柱·厘米左右,这是由于膜孔 间隔内的放电区向四周扩散,它很大程度上 取决于磁场的箍缩效应,因此,实际放电区的 有效半径将大于膜孔半径。



(R 为膜孔半径)

下面讨论影响确定最佳气压的一些因素:

· 31 ·

1. 最佳气压与放电电流密度的关系

实验证明, 气体温度和放电电流密度的 关系为^[77]:

 $T_g/300 = 1 + 0.9\pi J\sqrt{R}$ (15) 将(15)式代入(10)式,在最佳工作时,(10)式

的左边为一常数即

$$62.8aV_i\sqrt{M}\frac{PR}{1+0.9\pi J\sqrt{R}}=$$
常数 (16)

因此,随着电流密度的增加,最佳气压也必须 相应提高,这和 W. B. Bridges 等人的实验 结果相一致^[0]。而当电流密度较小时则 H. Boersch 的实验结果相一致,即最佳气压和 电流密度无关。

2. 最佳气压与纵向气体抽运的关系

由于大电流密度放电的纵向气体抽运效 应使放电区产生较大的纵向浓度梯度,则激 光的上能级粒子数产生率将正比于

$$\int_{P_{\mathbf{k}}}^{P_{\mathbf{k}}} F(PR) dP$$

*P*₄、*P*_k为阳极区、阴极区的气压。为使它最大,由图 2 *F*(*PR*)曲线不难理解,相应的最佳气压也将有所提高,因曲线左支比右支更陡。

3. 氧化铍陶瓷放电管 Ar⁺ 激光器 的最 佳气压定性解释

在上述分析中认为放电区的气体温度分 布是均匀的,这对于石英放电管,或石英管壳 分段石墨放电管是比较合适的。因为尽管采 用强迫冷却,径向温度梯度主要还是发生在 石英管壁内,但是,氧化铍导热良好,在强迫 冷却的情况下放电管内壁的温度很低,一般 小于 400K,为了将放电功率传递给管壁,必 然在放电区内存在着较大的径向温度梯度, 同时也将伴随着其他参量如气体浓度、电子 温度、电流密度、电子浓度等的径向分布,从 而导致上能级粒子数产生率的径向分布。为 求得单位长度放电管内上能级粒子数的产生 率,必须在整个放电截面内积分求解。这 是十分复杂的运算,故这里仅作某些定性解 释。

在管内压力平衡的情况下,管内各处符 合

$N_{g}T_{g}=常数。$

因此,由于管壁温度较低,这里集居稠密的气体分子层,电子温度较低,靠电子碰撞产生的 上能级粒子数也为数不多,上能级粒子数的 产生主要来源于管轴附近的放电区。因此, 相当于产生上能级粒子数的放电区有效半径 减小了。由(10)式可知对应于最佳电子平均 能量的最佳气压也将提高,这和 P. C. Cender 等人^[100]的实验结果也是基本一致的。

在上述理论分析中还有许多因素,它们 难以用简单的数学关系进行考虑。然而它们 对激光输出功率和最佳气压的确定都有一定 影响,这里仅择其主要因素进行了分析。

由于Ar+激光器结构的复杂和形式多种 多样,因此不宜象设计氦-氖激光管那样单纯 从 PR 值来确定最佳气压。实际最佳气压往 往高于上述理论所得的最佳功率充气压力。

参考文献

- [1] W. B. Bridges; Appl. Phys. Lett., 1964, 4, No. 7, 128~130.
- [2] J. Eichler, H. J. Eichler; Appl. Phys., 1976, 9, No. 1, 53~58.
- [3] L. Tonks, I. Langmuir; Phys. Rev., 1929, 34, 876~922.
- [4] K. G. Herngvist, J. R. Fendley; *IEEE J.*, *Quant. Electr.*, 1967, **QE-3**, No. 2, 66~72.
- [5] V. F. Kitaeva et al.; IEEE J., Quant. Electr., 1974, QE-10, No. 10, 803~808.
- [6] C. S. Willett, "Introduction to Gas Laser; Poputation Inversion Mechanism", 1794, New York.
- [7] A. N. Gherter; Phys. Rev., 1968, 169, No. 1, 184~193.
- [8] H. Boersch et al.; Phys. Lett., 1967, 24A, No. 12, 695~696.
- [9] W. B. Bridges, A. N. Chester; "Ionized Ges Lasers", in Handbook of Lasers (ed R. J. Pressloy), p. 242~297.
- [10] P. C. Conder et all.; The Radio and Electionic, 1970, 39, No. 2, 97~103.

· 32 ·